DIALOG(R)File 347:JAPI (c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04531081 **Image available**
OPTICALLY ACTIVE RECEPTABLE AND ASSEMBLY METHOD

PUB. NO.: 06-174981 **JP 6174981** A]
PUBLISHED: June 24, 1994 (19940624)

INVENTOR(s): KATO TAKESHI

YUKI FUMIO TANAKA KATSUYA

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 04-330463 [JP 92330463] FILED: December 10, 1992 (19921210)

INTL CLASS: [5] G02B-006/42

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD: R002 (LASERS); R012 (OPTICAL FIBERS)

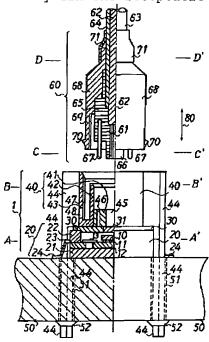
JOURNAL: Section: P, Section No. 1804, Vol. 18, No. 510, Pg. 82,

September 26, 1994 (19940926)

ABSTRACT

PURPOSE: To provide the high-density optical element module which can connect many optical fibers two-dimensionally to a wiring board and is adequate for optical interconnection of large-sized computers, wide band exchangers, etc.

CONSTITUTION: This receptacle type optical element module (optical active receptacle 1) is mounted with optical elements 10 of a two-dimensional array and has the receptacle 40 of the connector 60 of the optical fiber 61. Its optical axis direction and connector insertion and removal direction 80 are disposed perpendicularly to a package 20 and the wiring board 50. Legs 44 which perpendicularly penetrate the wiring board 50 and securely fix the receptacle 40 to the wiring board 50 are provided.



			•
	•		

DIALOG(R) File 345: Inpac / Fam. & Legal Stat (c) 2000 EPO. All rts. reserv.

11847384

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 6174981 A2 940624 <No. of Patents: 001> Patent Family:

JP 6174981 A2 046 Applic No. Kind Date

A2 940624 JP 92330463 A 921210 (BASIC)

Priority Data (No, Kind, Date): JP 92330463 A 921210

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No, Kind, Date): JP 6174981 A2 940624

OPTICALLY ACTIVE RECEPTABLE AND ASSEMBLY METHOD (English)

Patent Assignee: HITACHI LTD

Author (Inventor): KATO TAKESHI; YUKI FUMIO; TANAKA KATSUYA

Priority (No, Kind, Date): JP 92330463 A 921210 Applic (No, Kind, Date): JP 92330463 A 921210

IPC: * G02B-006/42

Derwent WPI Acc No: * G 94-243207; G 94-243207 JAPIO Reference No: * 180510P000082; 180510P000082

Language of Document: Japanese

					•
		•			
		•			
waret			•		
				·	

DIALOG(R) File 351: DERW WPI (c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

009975494 **Image available**
WPI Acc No: 1994-243207/199430

XRPX Acc No: N94-191829

Optical active receptacle device for computer interconnections - has receptacle fixed to package or cap which seals opening of package containing planar light emitting element NoAbstract

Patent Assignee: HITACHI LTD (HITA)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 6174981 A 19940624 JP 92330463 A 19921210 199430 B

Priority Applications (No Type Date): JP 92330463 A 19921210

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 6174981 A 9 G02B-006/42

Title Terms: OPTICAL; ACTIVE; RECEPTACLE; DEVICE; COMPUTER; INTERCONNECT; RECEPTACLE; FIX; PACKAGE; CAP; SEAL; OPEN; PACKAGE; CONTAIN; PLANE; LIGHT

; EMIT; ELEMENT; NOABSTRACT

Derwent Class: P81; V07
International Patent Class (Main): G02B-006/42

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): V07-G10A; V07-G10C

		•		
	,			
			٠.	
v-				

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-174981

(43)公開日 平成6年(1994)6月24日

(51) Int.Cl.⁵ G 0 2 B 6/42 識別記号

庁内整理番号 7132-2K FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数12(全 9 頁)

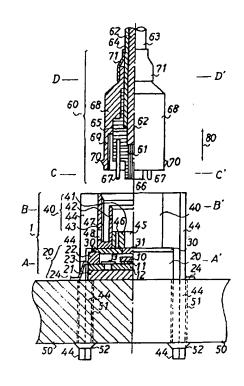
(21)出願番号	特願平4-330463	(71)出願人 000005108
		株式会社日立製作所
(22)出願日	平成4年(1992)12月10日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(72)発明者 加藤 猛
		東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地
		株式会社日立製作所中央研究所内
		(72)発明者 結城 文夫
		東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地
		株式会社日立製作所中央研究所内
		(72)発明者 田中 勝也
		東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地
		株式会社日立製作所中央研究所内
		(74)代理人 介理士 磯村 雅俊

(54) 【発明の名称】 光アクティブレセプタクルおよび組立方法

(57)【要約】

【目的】 配線ポードに対して2次元的に多数の光ファイバを接続でき、大型計算機や広帯域交換機等の光インタコネクションに好適な高密度光素子モジュールを提供する。

【構成】 レセプタクル型光素アモジュール(光アクティブレセプタクル1)において、2次元アレイの光素子10を搭載し、光ファイバ61のコネクタ60のレセプタクル40を備え、光軸方向およびコネクタ挿抜方向80をパッケージ20および配線ポード50に対して垂直に配し、配線ポード50を垂直に貫通し、レセプタクル40を配線ポード50に堅固に固定する脚44を備える。



1

【特許請求の範囲】

【讃求項1】 レセプタクル型モジュールにおいて、面 発光素子か面受光素子の何れかの2次元アレイが形成さ れた光素子と、該光素子を搭成するパッケージと、該光 素子に対する光透過部を有し、該パッケージを封止する キャップと、該パッケージかキャップの何れかに固定さ れ、光ファイバのコネクタを接続するレセプタクルと、 前記パッケージが搭載される配線ポードを垂直に貫通 し、該配線ボードに該バッケージか前記レセプタクルの タクルの光軸方向と、該レセプタクルに対する前記コネ クタの挿抜方向とを、前記パッケージのベースと前記配 線ポードとに対して垂直に配したことを特徴とする光ア クティブレセプタクル.

【請求項2】 上記キャップおよびレセプタクルは、一 体の部材から構成されたことを特徴とする請求項1記載 の光アクティブレセプタクル。

【請求項3】 上記脚は、上記レセプタクルと一体の部 材から構成され、上記パッケージの側面を通って上記配 線ポードを貫通することを特徴とする請求項1記载の光 20 アクティブレセプタクル。

【請求項4】 上記脚は、上記パッケージの四隅に配置 されたことを特徴とする請求項1記載の光アクティブレ セプタクル。

【請求項5】 上記脚は、上記パッケージのベースに固 定され、該ベースの底面から突き出て上記配線ポードを 貫通することを特徴とする請求項1記載の光アクティブ レセプタクル。

【 請求項 6 】 上記脚は、上記ペースの中央部に配置さ れたことを特徴とする請求項1記載の光アクティブレセ 30

【請求項7】 上記脚は、上記パッケージの側面に湾曲 したリードフレームからなる入山力端子を備えたことを 特徴とする請求項1記载の光アクティブレセプタクル。

【訪求項8】 上記ペースの底面に、スプリングピンの ピングリッドアレイからなる入出力端子を備えたことを 特徴とする請求項1記載の光アクティブレセプタクル。

るいは両方は、剛性部材から构成されたことを特徴とす る 前求項1記載の光アクティブレセブタクル。

【請求項10】 上記コネクタを支持・固定する手段 と、光ファイバの位置決め手段とを備えたことを特徴と する請求項1記载の光アクティブレセプタクル。

【請求項11】 請求項1記载の光アクティブレセプタ クルの組立方法において、上記レセプタクルを上記バッ ケージに固定する際、レーザ溶接により固定することを 特徴とする光アクティブレセブタクルの組立方法。

【請求項12】 請求項1記载の光アクティブレセプタ クルの組立方法において、上記脚の先端にメタライズを 施し、上記配線ボードに半田固定することを特徴とする 50

光アクティブレセプタクルの組立方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産券上の利用分野】本発明は、レセプタクル型光素子 モジュールに関し、特に大型計算機や広帯域交換機等の 光インタコネクションに好適な光アクティブレセプタク ルおよび組立方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、光インタコネクションに用いる光 何れかを固定する脚とを備え、前記光素子およびレセプ 10 素子モジュールとして、例えば、「プロシーディングス オブ エレクトロニック コンポーネンツ アンド テクノロジー コンファレンス、1992年、第77頁 -82頁(Proceedings of Elect ronic Components and Tech nology Conference, 1992, p p. 77-82)」、あるいは同誌、同年、第853頁 -860頁、同誌、1991年、第475頁-478頁 等に記載のピグテイル型モジュールが知られている。図 2は、従来のピグテイル型モジュールの概略を示す断面 図である。図2において、光素子810は4個から12 個の素子の1次元アレイである。図2の紙面の奥行き方 向に配列されている。光素子810が固定されたサブマ ウント811と、光素子810を駆動する半導体素子8 12は、メタルパッケージ820のステム821に搭载 されている。パッケージ820は、キャップ830によ って封止されている。813と814はワイヤ、822 は1/0端子である。4本から12本の光ファイバ86 1は、パッケージ820側面のホルダ823を通ってパ ッケージ820内部に導入されている。862は樹脂被 預された光ファイバリポンから成るピグテイルである。 ビグテイル862の先端には光コネクタ860が取り付 けられている。また、単体の光素子を搭環したレセプタ クル型光素子モジュールとしては、例えば、「電子情報 通信学会技術研究報告、OQE88-81、第47頁-52頁」、あるいは特開平1-243008号公報等に 記載のモジュールが知られている。図3は、従来のレセ プタクル型モジュールの概略を示す断面図である。 図3 において、単体の光奈子910は、サブマウント911 を介してメタルパッケージ920のステム921に搭載 40 されている。パッケージ920は、単レンズ931を有 するキャップ930により封止されている。922はⅠ **/〇端子である。光ファイパのコネクタが接続されるレ** セプタクル940は、スリープ941と、コネクタが固 定されるネジ部942と、鉧943から構成されてい る。スリープ941の孔944にコネクタのフェルール が挿入される。鉧943の孔945はネジ穴である。9 46は透明板である。メタルパイプ950は、パッケー ジ920に固定された後、951においてレセプタクル 910に溶接されている。

[0003]

.7

【発明が解決しようとする課題】従来、大型計算機や広 帯域交換機を高性能化するため、管体間接続または配線 ボード間接続の高スループット化が求められてきてい る。しかし、従来の電気同軸ケーブルとコネクタでは、 一般的に帯域幅数GHz・m、信号接続密度10本/c m²程度が限界と思われる。近年、この限界を打破する ため、光ファイパケーブルによる光インタコネクション が検討されている。光インタコネクションは、一般的に 電気接続に比べて高スループット、長距離、高密度とい う利点がある。上記従来のピグテイル型モジュールは、 前者2つの利点を活かし、数100Mb/sから数Gb /sで100m程度の筺体間接続を行うことが可能であ る。ボード間接続では、筐体間接続よりさらに高スルー プット化、高密度化が必要になる。接続距離は数mであ るので、長距離化は必要ない。大型計算機や広帯域交換 機の性能トレンドを考慮すると、将来には伝送スループ ット1Gb/s以上、接続密度10本/cm²以上の光 インタコネクションが必要になると推測される。しか し、上記従来技術におけるピグティル型モジュールで は、高密度化に対する配慮がなされていない。図2に示 20 したように、従来はパッケージ820側面から1次元的 に光ファイバ861を取り出しているので、モジュール 実装面積当たりの光ファイパ本数には限りがある。実 際、従来は数cm²から数10cm²程度の実装面積から 4から12本の光ファイパ861しか取り出していな い。また、接続密度は、数本/cm¹以下である。ま た、従来はポード上にモジュール実装エリアに加えて、 ピグテイル862の敷設エリアと光コネクタ860の実 装エリアが余分に必要である。以上から、上記ピグテイ ル型モジュールはポード間接続に適していない。また、 高密度化するためには、当然ながら、1つのモジュール に搭載する光素子数を増加し、かつモジュールを小型化 する必要がある。従来のピグテイル型モジュールでは、 上述した理由の他、1次元アレイの光素子数を増加する と非常に細長い素子の製作や取扱いが困難になる。そこ で、次の対策が考えられる。

- (1) 光素子として、面発光素子または面受光素子の2 次元アレイを用いる。
- (2) モジュールの I/O端子の増加 (多端子化) およ び小型化に対応するため、従来のメタルパッケージに代 40 えて、フラットパッケージやピングリッドアレイパッケ ージ等のセラミクスパッケージ類を用いる。
- (3) ピグテイル敷設エリアやコネクタ実装エリアを削 滅するため、レセプタクル型モジュールに変更する。 一方、従来のレセプタクル型構造では、図3に示したよ うに、レセプタクル940から突き出た幅5mm程度の 鍔943と、直径と高さが7mm程度のパイプ950が 小型化の妨げになる。 鍔943をポードにネジ止めする 場合、鍔913自身の面積が大きい上、ポードにパイプ

かも、端子922の数が増加すると、この貫通孔を通っ た端子922とボードとの接続が困難になる。逆に、貫 通孔を開けずに端子922をボードに接続する場合は、 鍔943とポードとの間にパイプ950と同じ高さのス ペーサを設ける等、永分な構造体が必要になる。また、 小型化のために鍔943を省略すると、レセプタクル9 40にコネクタを挿抜するときの応力や、レセプタクル 9 4 0 に接続されたコネクタおよび光ファイバの重力等 が、端子922やパイプ950に加わることになる。こ 10 れらの過大な応力は、端子922をボードに接続する半

田を疲労破壊させる原因になる。また、パイプ950と レセプタクル940との接続部951やパイプ950自 身の変形により、光素子910とレセプタクル940の 光軸がずれる心配がある。このように、従来のレセプタ クル型モジュールは、モジュールに対して直接コネクタ を挿抜することが可能であるが、単体の光素子しか搭載 しておらず、小型化が困難であるため、そのままではポ ード間接続には適用できない。本発明の目的は、このよ うな問題点を改善し、ボード間接続に適していて、光結 合や I / O端子と配線ポードとの接続の信頼性を向上す る高密度光素子モジュール(光アクティブレセプタク

[0004]

ル)を提供することにある。

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の光アクティブレセプタクルは、特に光素子 として面発光素子または面受光素子の2次元アレイを用 い、レセプタクル型モジュール構造を採用して、光素 子、パッケージ、光透過部を有するキャップ、レセプタ クル、脚等から構成したことに特徴がある。また、光素 30 子およびレセプタクルの光軸と、レセプタクルに対する コネクタの挿抜方向とを、パッケージのペースと配線ポ ードとに対して垂直に配する。さらに、前記脚は、配線 ボードを垂直に貫通し、バッケージまたはレセプタクル を配線ポードに堅固に固定する。また、コネクタを支持 ・固定する手段(例えば、フェルールガイドのガイド 孔、コネクタ先端の爪を引掛けるラッチ孔等)と、光フ ァイバの位置決め手段(フェルールガイドピン依合用の ガイド孔等)とを備えて、挿抜時の衝撃を緩和し、正確 な位置決めを可能とする。なお、これらの手段を用いて 構成したレセプタクル型光素子モジュールを光アクティ プレセプタクルと呼ぶ。また、上記光アクティブレセプ タクルを組み立てる場合には、レーザ溶接により、レセ プタクルをパッケージに固定し、また、脚の先端にメタ ライズを施してその脚を配線ボードに半田固定する。

[0005]

【作用】本発明においては、面発光素子または面受光素 了の2次元アレイを用いることにより、素子面積に依存 して素子数を増加することができる。従って、従来の1 次元アレイのように素子が一方向に細長くならないの 950が貫通する人きな孔を開けなくてはならない。し 50 で、製作や取扱上の困難は回避される。また、2次元ア

5

レイが形成された光素子の光軸をベースとポードに対し て垂直に配することにより、ボードから"面"として光 ファイバを取り出すことができる。従って、従来のピグ テイル型のようにパッケージ側面から"線"として光フ ァイバを取り出す場合と異なり、モジュール実装面積に 対する光ファイパ本数の制限は緩和される。また、レセ プタクル型モジュール構造を採用することにより、モジ ュールにコネクタを直接接続できる。従って、従来のビ グテイル型のようなモジュール外部のピグテイルやコネ クタが不要になるので、ピグテイル致設エリアやコネク 夕実装エリアが削減される。また、ボードを貫通する脚 によってバッケージまたはレセプタクルをボードに固定 することにより、従来のレセプタクル型のような鉧、ボ ードにパイプを通す貫通孔、鍔とボードの間のスペーサ 等の余分な構造体が不要になる。さらに、脚をポードに 垂直に貫通させ、レセプタクルの光軸とコネクタの挿抜 方向とをボードに対して垂直に配することにより、挿抜 に伴う広力やコネクタと光ファイバの重力を脚を介して ポードに逃がすことができる。従って、従来のレセプタ クル型のように応力や重力がI/O端子やパイプに対し 20 て直接加わることはない。

[0006]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面により説明す ろ。

(第1の実施例) 図1は、本発明の第1の実施例におけ る光アクティブレセプタクルの正面図および断面図(図 4~図7のE-E'線断面図) である。また、図4~図 7は、それぞれ図1のA-A'線断面図、B-B'線断 面図、C-C'線断面図、D-D'線断面図である。本 実施例の光アクティブレセプタクル1は、面発光素子ま 30 たは面受光素子の2次元アレイが形成された光素子10 と、光素了10が搭環されるパッケージ20と、光素子 10に対する光透過部31を有し、パッケージ20を封 止するキャップ30と、キャップ30に堅固に固定さ れ、光ファイバ61のコネクタ60が接続されるレセプ タクル40とを備えている。また、光素了10およびレ セプタクル40の光軸方向80と、レセプタクル40に 対するコネクタ60の挿抜方向80とを、パッケージ2 0のペース21と、バッケージ20が搭載される配線ポ ード50とに対して垂直に配している。さらに、配線ボ 40 ード50を垂直に貫通し、レセプタクル40を配線ボー ド50に堅固に固定する脚44を備えている。以下、順 を追って各部を説明する。まず、光素了10は、InP 系化合物半導体から成る。その表面(図1の下側、図4 の裏側)には、高周波特性に似れた面発光レーザダイオ ードまたは p - i - n 型面受光ホトダイオードの 2 次元 アレイが形成されている。2次元アレイは、所望のスペ ックに応じて8~12列×2~8行程度の案子から構成 される。アレイピッチは、光ファイパ61の直径や配列 ピッチを考慮し、通常250μmに設定される。レーザ 50 く。次に、レセプタクル40全体を保持しながら光素子

ダイオードの発振光またはホトダイオードの検出光は、 光素子10の裏面(図1の上側、図4の表側)から出射 または入射される。光素子10は、低容量かつ低インダ クタンスの半田パンプ11によって半辺体素子12にフ リップチップ接続されている。また、半導体素子12 は、Siから成り、レーザダイオードのドライバ回路 等、またはホトダイオードのアンプ回路と信号識別回路 等が形成されていて、光素子10の2次元アレイを独立 に駆動するため、アレイの各素子毎に回路を有してい る。また、半導体素子12は、パッケージ20のペース 21に半田付けされており、その電極は図4に示すよう に配線テープキャリア13によってバッケージ20のフ レーム23に接続されている。この配線テープキャリア 13は、配線パターンとグランドの2層から成り、優れ た高周波特性を有する。また、バッケージ20は、セラ ミクス製フラットパッケージの一種であり、図1と図4 に示すように、ペース21、フレーム22、23、1/ 〇端子24から構成されている。このペース21、フレ ーム22、23の材料には、光素子10と半導体素子1 2の放熱および高速信号伝送を考慮し、高熱伝導率と低 誘電率を有するAINセラミクスを用いている。また、 フレーム22の上面にはコパール合金製シールリングが 形成され、フレーム23には配線パターンと終端抵抗が 形成されている。また、I/O端子24は、リードフレ ームであり、図1に示すように、湾曲したガルウィング 形状に成形され、配線ボード50に半田接続されてい る。また、キャップ30の光透過部31は、ガラス板か ら成る。その表面には、光素子10と光ファイバ61の 光結合効率を高めるため、屈折率分布型マイクロレンズ の2次元アレイが250 μmビッチで形成され、無反射 コーティングが施されている。さらに、光透過部31 は、低融点ガラスによってキャップ30に固定されてい る。このキャップ30は、コパール合金から成る。な お、パッケージ20の封止工程では、キャップ30全体 を保持しながら光素子10とレンズアレイの光軸合わせ を行った後、固定箱度の良好なレーザ溶接によってフレ ーム22のシールリングに一旦仮固定する。この後、さ らにキャップ30の1辺をシーム溶接し、図1に示すよ うにパッケージ20を封止する。また、レセプタクル4 0は、図1と図5に示すように、フェルールガイド4 1、スリープ42、ソケット43、脚44から成る。こ のフェルールガイド 41 には、精密樹脂成形によってガ イド孔45、46が加工されている。また、スリーブ4 2、ソケット43および脚44は一体であり、研削また はマイクロ溶接によって加工される。この材料には高剛 性のコパール合金が用いられる。 さらに、ソケット43 にはガイド溝47とラッチ孔48が加二されている。本 実施例のレセプタクル40の組立工程では、予めフェル ールガイドイ1をスリーブイ2の内側に嵌め込んでお

10とレンズアレイに対して光軸合わせを行う。最後 に、既にパッケージ20に固定されたキャップ30に対 し、レセプタクル40をレーザ溶接によって精密かつ堅 固に固定する。また、脚44は、図5に示すように、ソ ケット43の外周に梁のようにつながっており、図4に 示すように、パッケージ20の四隅の側面を通ってい る。これにより、光アクティブレセプタクル1を配線ポ ード50に搭載する際は、図1に示すように、脚44は 配線ボード50のスルーホール51を貫通する。さら に、脚44の先端にはメタライズが施されており、配線 ポード50に半田52によって堅固に固定される。ま た、配線ポード50は、低誘電率、高耐熱性、高強度を 有する多層プリント配線基板から成り、配線パターン は、インピーダンス整合するように設計されている。な お、1/0端子24が接続される電極、スルーホール5 1、脚44が固定される半田52のランドは、配線パタ ーンと同時に形成される。また、コネクタ60は、光フ ァイパケーブル63の先端に取り付けられている。図 1、図6、図7に示すように、フェルール65、プラグ 68、カバー71から構成されている。このフェルール 20 65には、フェルールガイド41と同様の精密樹脂成形 によって、凸部66、光ファイバ61およびガイドピン 67の挿入孔、光ファイパケーブル63のガイド溝が加 工されている。なお、フェルール65の組立工程では、 光ファイバ61を孔に挿入した後、光ファイバケーブル 63とともにフェルール65に接着する。さらに、凸部 66の光ファイパ61の端面を光学研磨し、ガイドピン 67を孔に接着する。こうして、光ファイバ61は2次 元アレイとして高精度に配列される。また、ブラグ68 は、軽量かつ高強度のプラスチックから成り、スプリン 30 グ69と爪70が成形加工されている。そして、図1に 示すように、組立後のフェルール65に被せて接着され る。また、図7に示すように、プラグ68と光ファイバ ケーブル63の間隙72は樹脂接着剤によって充填され る。また、プラグ68の保護カバー71は、熱収縮チュ ープから成り、プラグ68と光ファイバケーブル63に 被せた後、加熱によって収縮させる。また、光ファイバ ケーブル63では、図7に示すように、2~8層の光フ ァイバリポン62が外被64によって被覆されている。 この光ファイパリポン62では、8~12本の光ファイ 40 パ61が樹脂によって被覆されている。また、光ファイ パ61は、直径125μm、コア径50μmのグレーテ ッドインデックス型マルチモードファイパから成り、伝 送帯域幅は約800GHz・mである。

【0007】本実施例では、コネクタ60をレセプタクル40に接続する場合、スリーブ42とソケット43の間にコネクタ60のプラグ68を挿入し、スリーブ42にフェルール65を挿入する。この際、フェルールガイド41のガイド45、46には、それぞれフェルール550凸部66とガイドピン67が挿入される。なお、

8 凸部66のサイズはガイド孔45よりわずかに小さい。 こうして、フェルール65の位置すなわち光ファイバ6 1の位置は、ガイドピン67とガイド孔46の嵌合によ って正確に決まる。さらに、ガイド滯47に沿ってプラ グ68のスプリング69を導き、その先端の爪70をラ ッチ孔48に引っ掛けることにより、コネクタ60とレ セプタクル40は簡便に接続される。一方、コネクタ6 0を外す際は、爪70をラッチ孔18の内側に押さえな がら引き抜く。このようにしてコネクタ60を接続した 場合、光ファイパ61と光素子10は約-4±1dBと いう高い効率で光結合される。第1実施例の組立工程に おける精度配分は、光素子10 (パッケージ20) とレ ンズアレイ(キャップ30)の固定精度約2μm、レン ズアレイ (キャップ30) とレセプタクル40の固定精 度約5μm、フェルール65による光ファイバ61の配 列精度約1μm、フェルール65とフェルールガイドの 嵌合精度約1 μmとなっている。より高い効率を所望す る場合は、光素子10のスポットサイズやレンズの焦点 距離を考慮した上で、部品精度と固定精度を上げる。

【0008】本実施例によれば、光素子10と光ファイ バ61の光結合、および1/0端子24と配線ポード5 0との接続を信頼性良く行うことができる。また、レセ プタクル40と一体の部材から成る4本の脚44が、パ ッケージ20の四隅の側面を通って、コネクタ60の挿 抜方向80と同様に垂直に配線ポード50を貫通し、半 田52によって堅固に固定されているので、コネクタ6 0を挿抜する際の応力やコネクタ60と光ファイバケー プル63の重力は、レセプタクル40から脚44を介し て配線ポード50に分散される。また、パッケージ20 とキャップ30は、例えて言えば吊るし天井のように脚 44から成る4本の支柱によって支えられているので、 歪むことはない。このパッケージ20は高剛性セラミク スから成り、キャップ30はパッケージ20に堅固に固 定されているので、パッケージ20およびキャップ30 自身も歪みにくい。また、コネクタ60の材料には軽量 のプラスチックや樹脂が用いられているので、レセプタ クル40に加わる重力は低減されている。また、脚44 はレセプタクル10の四隅を梁のように補強しているの で、コネクタ60の挿抜方向80に垂直な応力に対して もレセプタクル40は高い強度を有している。従って、 脚44に微小な変形が生じた場合でも、この変形は高剛 性のパッケージ20を介してI/O端子21に伝わり、 湾曲部分のパネによって吸収されるので、1/0端子2 4と配線ポード50を接続する半田が歪むことはない。 また、キャップ30はパッケージ20にレーザ溶接によ って精密かつ堅固に固定されており、AIN製のパッケ ージ20やコパール合金製のキャップ30とレセプタク ル40の熱膨張係数はほぼ等しいので、熱応力による歪 みは低減されている。以上から、光素子10と光ファイ 50 パ61の位置すれ、I/O端子24と配線ポード50を

接続する半田の疲労破壊等が生じることはない。従っ

て、信頼性を低下させることなく、従来よりモジュール

を小型化することが可能になる。また、本実施例では、

光アクティブレセプタクル1に対し、コネクタ60を爪

70とラッチ孔48によって簡便に取外しすることが可

能である。また、コネクタ60のフェルール65やプラ

グ68は成形加工されているので、量産した場合に低コ

スト化を図ることができる。これにより、従来のピグテ

イル型のようなピグテイルファイバやコネクタの余分な

面積を削減し、高密度化することが可能になる。また、

本実施例では、光素子10として面発光レーザダイオー

ドと面受光ホトダイオードの2次元アレイを用いている

ので、従来の1次元アレイに比べて任意に素子致を増加

することができる。 さらにきせ 次元アレイのように素子

が非常に細長くなることがなく、製作や取扱上の不便が

なくなる。また、光素子10の光軸をベース21および

配線ポード50に垂直に配しているので、配線ポード5

0に対して2次元的に光ファイバ61を接続することが

続より優位にあることは明らかである。以上から、モジ

ュールを小型化し、かつ多数の光ファイバを接続するこ

とができるので、光インタコネクションの接続密度の向

上に効果がある。また、モジュールは高周波特性に優れ

た部品によって構成されているので、伝送スループット

【0009】 (第2の実施例) 図8は、本発明の第2実

施例における光アクティブレセプタクルの正面図および

断面図(図8~図12のJ-J'線断面図)である。ま

図、G-G、線断面図、H-H、線断面図、I-I、線

断面図である。本実施例の光アクティブレセプタクル2

は、面発光素子または面受光素子の2次元アレイが形成

された光茶子110と、光茶子110が搭载されるパッ

ケージ120と、光素子110に対する光透過部147

およびパッケージ120を封止するキャップ143を有

し、光ファイバ161のコネクタ160が接続されるレ

セプタクル110とを備えている。また、光案子110

およびレセプタクル140の光軸方向180と、レセプ

タクル140に対するコネクタ160の挿抜方向180 とを、パッケージ120のペース121とパッケージ1

20が搭載される配線ボード150とに対して垂直に配

している。さらに、配線ポード150を垂直に貫通し、

パッケージ120を配線ポード150に堅固に固定する 脚124を備えている。以下、順に詳しく各部について

説明する。まず、光素子110は、超高速光信号の送受

信に適したGaAs系化合物半導体OEICから成る。

た、図8~図12は、それぞれ図8のF-F'線断面 30

の向上に効果がある。

クに形成されている。また、発振光が出射され、あるい は検出光が入射される宴面(図8の上側、図9の表側) には、両面マスクアライナによるパターニングとドライ エッチング加工によって、図9に示すように凸レンズ1 12の2次元アレイが形成されている。また、光素子1 10は、半田パンプ111によってパッケージ120の

10

ペース121にフリップチップ接続されている。これ は、半田パンプ111が低容量かつ多端子の接続に優れ ていることによる。また、パッケージ120は、セラミ 実装エリアが不要になるので、実質的にモジュール実装 10 クス製ピングリッドアレイパッケージの一種であり、図 8に示すように、ペース121、フレーム122、1/

> 〇端子123、脚124から構成されている。このペー ス121には、光素子110に近い熱膨張係数と低誘電 率を有するムライト系セラミクス多層配線基板が用いら

れており、配線パターンとともに、半田パンプ1111と 1/0端子123の電極や終端抵抗が形成されている。 また、フレーム122には、ペース121と同じ材料を 用いている。また、ピングリッドアレイを成すI/O端

子123は、空洞125によってパネ性を持たせたスプ できる。2次元接続が、接続密度の点で従来の1次元接 20 リングピンであり、I/O端子123の先端は、配線ボ ード150に半田接続されている。また、脚124は、

> パッケージ120に比較的近い熱膨張係数を有し、高熱 伝導性のCu-W合金から成る。そして、予めベース1 21の底面の中央部に高融点ろう材によって堅固に固定

されている。なお、多層プリント配線基板から成る配線 ポード150に光アクティブレセプタクル2を搭載する 際には、図8に示すように、脚124は、スルーホール

151を垂直に貫通し、その先端には低融点半田によっ

て放熱フィン152が堅固に固定される。また、レセプ タクル140は、図8と図10に示すように、フェルー ルガイド141、スリープ142、キャップ143、光

透過部147から成る。このフェルールガイド141 は、第1実施例と同様に精密樹脂成形によってガイド孔

144、145が加工されている。また、スリーブ14 2とキャップ143は一体であって、高剛性かつ低熱膨 張のステンレス合金から成り、スリープ142には雄ネ

ジ146が加工されている。また、光透過部147は、 無反射コーティングを施したガラス板である。なお、レ セプタクル140の組立工程では、まず光透過部147

40 を低融点ガラスによって固定し、フェルールガイド14 1を嵌め込んでおく。次に、レセプタクル140全体を 保持して光素子110に対して光軸合わせを行った後、

キャップ143の部分をパッケージ120のフレーム1 22にレーザ溶接によって一旦仮固定する。 最後に、キ ャップ143の4辺をシーム溶接し、パッケージ120

を封止する。また、コネクタ160は、図8、図11、 図12に示すように、フェルール165、ナット16 8、ストッパ171から構成されている。このフェルー ル165には、光ファイバ161およびガイドピン16

その表面(図8の下側、図9の裏側)には、面発光レー ザダイオードまたは面受光ホトダイオードの2次元アレ イとともに、これらを独立に駆動する回路がモノリシッ 50 7の挿入孔と、凸部166が成形加工されている。ま

-536---

11

た、凸部166の端面では、光ファイバ161が2次元 的に高精度に配列されている。また、ナット168はス テンレス合金から成り、レセプタクル140の雄ネジ1 46に合う雌ネジ169と、突起170が加工されてい る。また、ストッパ171は、プラスチックから成る。 そして、図8と図11に示すように、ナット168はフ ェルール165の回りを回転するが、突起170がフェ ルール165のエッジとストッパ171に引っ掛かるの で抜け落ちない。また、光ファイバケーブル163で は、図12に示すように、多層の光ファイバリボン16 2が外被164によって被覆されている。さらに、光フ ァイバリボン162では、多数本の光ファイバ161が 樹脂被覆されている。なお、各光ファイバ161は、直 径125 µm、コア径10 µmのシングルモードファイ バから成り、このシングルモードファイバの伝送帯域幅 は、全分散と光素子110の発振波長幅に依存し、第1 実施例のマルチモードファイバより格段に広い。

【0010】本実施例では、コネクタ160をレセプタ クル140に接続する際は、スリーブ142にフェルー ル165を挿入し、ナット168の雌ネジ169をレセ 20 プタクル140の雄ネジ146に締め付ける。この際、 フェルールガイド141のガイド孔144、145に は、それぞれフェルール165の凸部166とガイドビ ン167が挿入される。これにより、フェルール165 すなわち光ファイバ161は、ガイドピン167とガイ ド孔145によって正確に位置決めされる。また、コネ クタ160の接続時には、光ファイバ161と光素子1 10は約6 d B 前後の損失で光結合される。本実施例の 組立工程では、光素子110の凸レンズ112の加工精 度が約2μm、レセプタクル140の固定精度約5μ 30 m、フェルール165による光ファイバ161の配列精 度約0.5μm、フェルール165とフェルールガイド 141の嵌合精度約0.5μmである。

【0011】本実施例によれば、第1実施例と同様に、 光素子110と光ファイバ161の光結合、および1/ 〇端了123と配線ポード150との接続を信頼性良く 行うことができる。また、バッケージ120のベース1 21に堅固に固定された脚124が、コネクタ160の 挿抜方向180と同様に垂直に配線ポード150を貫通 し、放熱フィン152によって堅固に固定されているの 40 示す断面図である。 で、コネクタ160を挿抜する際の応力やコネクタ16 0と光ファイパケーブル163の重力は、高剛性のパッ ケージ120と脚124を介して配線ポード150に逃 げる。なお、パッケージ120の微小変形は、1/〇端 子123のスプリングによって吸収されるので、1/0 端子123と配線ポード150を接続する半田が疲労破 壊することはない。また、レセプタクル140、パッケ ージ120、光素子110の熱膨張係数はほぼ等しいの で、レセプタクル110とパッケージ120のレーザ溶 接部や半田111に加わる熱応力が低減される。また、

本実施例では、光素子110に凸レンズ112をモノリ シックに形成し、レセプタクル140とキャップ143 を一体化したことによって、第1実施例より組立工程を 簡略化し、モジュールを小型化することが可能である。 しかも、シングルモードファイバとしては比較的高い光 結合効率を得ることができる。また、コネクタ160の 接続は、ナット168によって簡便に行うことが可能で ある。さらに、光素子110としてOEICを用い、光 ファイバ161としてシングルモードファイバを用いて いるので、伝送スループットの向上に効果がある。な お、光素子110が発生した熱は、半田パンプ111、 ペース121、脚124を介して放熱フィン152に逃 げるので、光素子110の高集積化と高スループット化 によって消費電力が増加した場合にも十分に冷却するこ とができる。なお、上記実施例の他にも、要件(光素子 の2次元アレイを搭載したレセプタクル型モジュール、 配線ポードに垂直な光軸方向およびコネクタ挿抜方向、 配線ポードを垂直に貫通する脚等)を満たした構成であ

12

[0012]

れば、同様の効果を得ることができる。

【発明の効果】本発明によれば、モジュールに搭載する 光素子の素子数を増加させ、配線ポード上の"面"から 多数の光ファイバを取り出すことができる。また、従来 のピグテイル型における配線ポード上の余分な実装エリ アを削減し、従来のレセプタクル型における余分な構造 体を削除して、モジュールを小型化し、実装面積を低減 することができる。したがって、実装面積当たりの光フ アイパ本数を増加させ、接続密度を向上することができ る。さらに、従来のレセプタクル型において光結合構造 部やI/〇端子に加わっていた応力を低減し、光結合や I/O端子と配線ボードとの接続の信頼性を向上するこ とができる。以上により、大型計算機や広帯域交換機等 のボード間光インタコネクションに適した高密度光素子 モジュールを実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例における光アクティブレセ ブタクルの正面図(右側)および断面図(左側)であ

【図2】従来のピグテイル型光素子モジュールの概略を

【図3】従来のレセプタクル型光素子モジュールの概略 を示す断面図である。

【図4】図1のA-A'線断面図である。

【図5】図1のB-B 線断面図である。

【図6】図1のC-C'線断面図である,

【図7】図1のD-D'線断面図である。

【図8】本発明の第2実施例における光アクティブレセ プタクルの正面図(右側)および断面図(左側)であ

【図9】図8のF-F'線断面図である。 50



(8) 特開平6-174981

13 【図10】図8のG-G'線断面図である。

【図11】図8のH-H'線断面図である。

【図12】図8の1-1、線断面図である。

【符号の説明】

10…光素子

20…パッケージ

21…ペース

30…キャップ

3 1 …光透過部

40…レセプタクル

44…脚

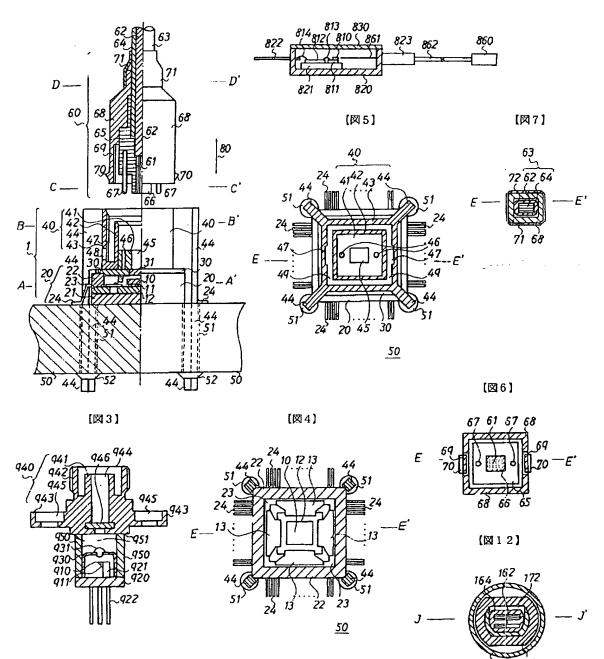
50…配線ポード

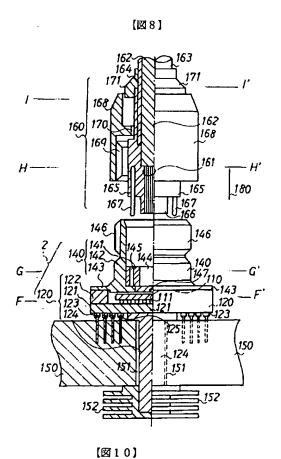
60…コネクタ

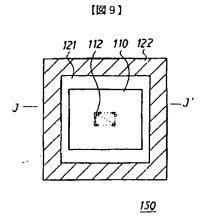
61…光ファイバ

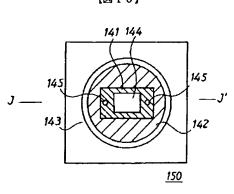
80…光軸方向およびコネクタ挿抜方向

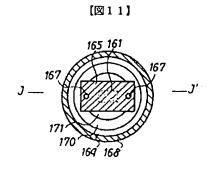
[図1] (図2]











.

******* ****** ******

.